EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2001002724

PUBLICATION DATE

09-01-01

APPLICATION DATE

24-06-99

APPLICATION NUMBER

11178552

APPLICANT: TOSOH CORP;

INVENTOR: YOSHIDA OSAMU;

INT.CL.

C08F 4/69 C08F110/02

TITLE

ETHYLENE TRIMERIZATION CATALYST AND ETHYLENE TRIMERIZATION USING

THE SAME

ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject catalyst capable of efficiently producing in high selectivity 1-hexene useful as a raw material comonomer for linear low-density polyethylenes, from ethylene by including a specific chromium complex, an alkylmetallic compound and a specific amine compound.

SOLUTION: This catalyst is obtained by including the following at least three components: (A) a chromium complex coordinated with a neutral multidentate ligand, (B) an alkylmetallic compound and (C) an aromatic t-amine compound (except imine) and/or nitrogen-contq, heterocyclic compound, wherein it is preferable that the component A is a complex represented by the formula: ACrBn (A is a neutral multidentate ligand; (n) is 1-3; B is H. a 1-10C alkyl, a carboxylate, or the like), a chromium complex with the multidentate ligand having tripod-type structure and coordinated facially, esp. tris(3,5dimethylpyrazoly)methane.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-2724 (P2001-2724A)

(43)公開日 平成13年1月9日(2001.1.9)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

C 0 8 F 4/69

110/02

C08F 4/69

4J028

110/02

4J100

審査請求 未請求 請求項の数8 〇L (全 13 頁)

(21)出願番号

特願平11-178552

(71)出願人 000003300

東ソー株式会社

(22)出願日

平成11年6月24日(1999.6.24)

山口県新南陽市開成町4560番地

(72)発明者 三村 英之

山口県新南陽市土井2-15-4

(72)発明者 小栗 元宏

三重県四日市市別名6丁目7-8

(72)発明者 山本 敏秀

三重県四日市市別名3丁目5-1

(72)発明者 岡田 久則

三重県四日市市垂坂町366-1

(72)発明者 吉田 統

三重県桑名市新西方 5 -304

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 エチレンの三量化触媒及びこれを用いたエチレンの三量化方法

(57)【要約】

【課題】 エチレンから効率よく、かつ高選択的に1-ヘキセンを製造する。 ***

【解決手段】 (a)中性の多座配位子が配位したクロム錯体、(b)アルキル金属化合物及び(c)三級芳香族アミン化合物(イミンを除く)及び/または窒素含有複素環式化合物の少なくとも3成分からなる触媒を用いる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】(a)中性の多座配位子が配位したクロム 錯体、(b)アルキル金属化合物及び(c)三級芳香族 アミン化合物(イミンを除く)及び/または窒素含有複 素環式化合物の少なくとも3成分からなるエチレンの三 量化触媒。

【請求項2】中性の多座配位子が配位したクロム錯体が、下記一般式(1)

 $ACrB_n$ (1)

(式中、Aは中性の多座配位子である。nは1~3の整数であり、Bは水素原子、炭素数1~10のアルキル基、炭素数1~10のジャトナート基、ハロゲン原子、アミド基、イミド基、アルコキシド基、チオアルコキシド基、カルボニル配位子、アレーン配位子、アルケン配位子、アルキン配位子、アシ配位子、イミン配位子、ニトリル配位子、イソニトリル配位子、ホスフィン配位子、ホスフィンオキシド配位子、ホスファイト配位子、エーテル配位子、スルホン配位子、スルホキシド配位子、スルホキシド配位子、スルホン配位子、スルホキシド配位子のびスルフィド配位子からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される錯体であることを特徴とする請求項1に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項3】中性の多座配位子が三脚型構造を有することを特徴とする請求項1または請求項2に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項4】中性の多座配位子がfacialに配位したクロム錯体であることを特徴とする請求項1乃至請求項3に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項5】中性の多座配位子がトリス(3,5ージメチルピラゾリル)メタンであることを特徴とする請求項1乃至請求項4に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項6】上記一般式(1)におけるBが、ハロゲン原子、アミド基、アルコキシド基、チオアルコキシド基及びカルボニル配位子からなる群より選ばれる1種以上であることを特徴とする請求項1乃至請求項5に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項7】アルキル金属化合物が、下記一般式(2) R_b M X_a (2)

(式中、pは0 < p ≤ 3であり、qは0 ≤ q < 3であって、しかも p + qは1~3である。Mはリチウム、マグネシウム、亜鉛、ボロンまたはアルミニウムを表し、Rは炭素数1~10のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表し、Xは水素原子、アルコキシド基、アリール基及びハロゲン原子からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される化合物であることを特徴とする請求項1乃至請求項6に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項8】請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の エチレンの三量化触媒の存在下で、エチレンを三量化す ることを特徴とするエチレンの三量化方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エチレンの三量化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法に関する。 さらに詳しくは、線状低密度ポリエチレン(LLDPE)の原料コモノマーとして有用な1-ヘキセンをエチレンから効率よく、かつ高選択的に製造するエチレンの三量化触媒及びこれを用いたエチレンの三量化方法に関する。

[0002]

【従来の技術】エチレンを三量化して1-ヘキセンを得る方法において、特定の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキルアルミニウム化合物からなる触媒を用いることは公知である。例えば、特開平10-7712号公報には特定の窒素配位子が配位したクロムの塩素錯体やアルキル錯体とアルミニウム化合物からなる触媒が、特開平10-231317号公報には環状ポリアミンまたはヒドロトリス(ピラゾリル)ボレートが配位したクロム錯体とアルキルアルミニウム化合物からなる触媒が開示されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、特開平10-7712号公報に記載の方法は、触媒活性が低いという問題があった。また、オリゴマー中の1-ヘキセン選択性も低く、工業的な観点から十分なものではなかった。また、特開平10-231317号公報に記載の方法も触媒活性は低かった。さらに、選択性に関しても1-ヘキセンよりもポリエチレンの生成が多いばかりか、オリゴマー中の1-ヘキセン選択性も低いという欠点があった。

【0004】本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的はLLDPEの原料コモノマーとして有用な1-ヘキセンをエチレンから効率よく、かつ高選択的に製造することができるエチレンの三量化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課題を解決するため鋭意検討を行った結果、中性の多座配位子が配位したクロム錯体、アルキル金属化合物及び特定のアミン化合物の少なくとも3成分からなるエチレンの三量化触媒を用いると高い活性でエチレンの三量化反応が進行し、高選択的に1-ヘキセンが生成することを見い出し、本発明を完成するに至った。

【0006】即ち本発明は、(a)中性の多座配位子が配位したクロム錯体、(b)アルキル金属化合物及び(c)三級芳香族アミン化合物(イミンを除く)及び/または窒素含有複素環式化合物の少なくとも3成分からなるエチレンの三量化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法に関する。

[0007]

【発明の実施の形態】次に、本発明についてさらに詳し く説明する。

【0008】本発明においては、エチレンの三量化触媒 を構成する一成分として、(c)三級芳香族アミン化合 物(イミンを除く)及び/または窒素含有複素環式化合 物が用いられる。三級芳香族アミン化合物(イミンを除 く)としては特に限定されるものではないが、例えば、 N, N-ジメチルアニリン、N, N-ジエチルアニリ ン、N、Nージイソプロピルアニリン、N、Nージブチ ルアニリン、N、Nージベンジルアニリン、ジフェニル メチルアミン、トリフェニルアミン、トリス(p-メチ ルフェニル) アミン、トリス (m-メチルフェニル) ア ミン、トリス (oーメチルフェニル) アミン、N, N-ジメチルーロートルイジン、N、Nージメチルーmート ルイジン、N, Nージメチルーpートルイジン、N, N, 2, 3-テトラメチルアニリン、N, N, 2, 4-テトラメチルアニリン、N, N, 2, 5ーテトラメチル アニリン、N, N, 2, 6-テトラメチルアニリン、 5-テトラメチルアニリン、N, N-2, 3, 4-ペン タメチルアニリン、N, N-2, 3, 5-ペンタメチル アニリン、N, N-2, 4, 6-ペンタメチルアニリン、N, N-3, 4, 5-ペンタメチルアニリン、<math>N,N-2, 3, 4, 5, 6 -N79 \times 4 ν 7 \sim 1 ν 1 ν 1, N1, N-ジメチルー2-エチルアニリン、N, N-ジメチル -3-エチルアニリン、N, N-ジメチル-4-エチル アニリン、N, Nージメチルー6ーエチルーoートルイ ジン、N, Nージメチルー2ーイソプロピルアニリン、 N. N-ジメチル-4-イソプロピルアニリン、N, N ージメチルー2ーtーブチルアニリン、N, Nージメチ ルー4-s-ブチルアニリン、N, N-ジメチル-4t-ブチルアニリン、N、N-ジメチル-2、6-ジエ チルアニリン、N、N-ジメチル-6-イソプロピルー oートルイジン、N, Nージメチルー2ーフルオロアニ リン、N、Nージメチルー3ーフルオロアニリン、N、 N-ジメチルー4-フルオロアニリン、N, N-ジメチ ルー2, 3-ジフルオロアニリン、N, N-ジメチルー 2, 4-ジフルオロアニリン、N, N-ジメチル-2, 5-ジフルオロアニリン、N, N-ジメチル-2, 6-ジフルオロアニリン、N, N-ジメチル-3, 4-ジフ ルオロアニリン、N, N-ジメチル-3, 5-ジフルオ ロアニリン、N, N-ジメチル-2, 3, 4-トリフル オロアニリン、N, N-ジメチル-2, 3, 5-トリフ ルオロアニリン、N, N-ジメチル-2, 4, 6-トリ フルオロアニリン、N, N-ジメチル-3, 4, 5-ト リフルオロアニリン、N, N-ジメチルー2, 3, 4, 5,6-ペンタフルオロアニリン、N. N-ジメチルー 3, 5-ビス (トリフルオロメチル) アニリン、N, N ージメチルー2ークロロアニリン、N, Nージメチルー 3-クロロアニリン、N, N-ジメチル-4-クロロア ニリン、N, Nージメチルー2ープロモアニリン、N, Nージメチルー3ープロモアニリン、N, Nージメチルーの一アニシジン、N, Nージメチルーの一アニシジン、N, Nージメチルーmーアニシジン、N, Nージメチルーの一フェネチジン、N, Nージメチルーmーフェネチジン、N, Nージメチルーローフェネチジン、N, Nージメチルーローフェネチジン、N, Nージメチルーローフェネチジン、N, Nージメチルーコーアミノナフタレン、N, Nージメチルーコーアミノフルオレン、N, Nージメチルーコーアミノフルオレン、N, Nージメチルーコーアミノフルオレン、N, Nージメチルーコーアミノフルオレン、N, Nージメチルーコーアミノフルオレン、N, Nージメチルーコーアミノビフェニル、N, Nージメチルー4ーアミノビフェニル、N, Nージメチルーロートリメチルシリルアニリン等が挙げられる。

【0009】また、窒素含有複素環式化合物としては特 に限定されるものではないが、例えば、ピリジン、2-メチルピリジン、3-メチルピリジン、4-メチルピリ ジン、2,3-ジメチルピリジン、2,4-ジメチルピ リジン、2,5ージメチルピリジン、2,6ージメチル ピリジン、2、3、4ートリメチルピリジン、2、3、 5ートリメチルピリジン、2,4,6ートリメチルピリ ジン、2-エチルピリジン、3-エチルピリジン、4-エチルピリジン、2-イソプロピルピリジン、4-イソ プロピルピリジン、2-t-ブチルピリジン、4-t-ブチルピリジン、2,6-ジエチルピリジン、2,6-ジーnープロピルピリジン、2,6-ジーi-プロピル ピリジン、2,6ージフェニルピリジン、2,6ージー t-ブチルピリジン、2-メチル-6-エチルピリジ ン、2-メチルー6-イソプロピルピリジン、2-フル オロピリジン、3-フルオロピリジン、4-フルオロピ リジン、2,3-ジフルオロピリジン、2,4-ジフル オロピリジン、2,5ージフルオロピリジン、2,6-ジフルオロピリジン、2,3,4-トリフルオロピリジ ン、2、3、5ートリフルオロピリジン、2、4、6-トリフルオロピリジン、ペンタフルオロピリジン、2-クロロピリジン、3-クロロピリジン、4-クロロピリ ジン、2-ブロモピリジン、3-ブロモピリジン、4-プロモピリジン、2-メトキシピリジン、3-メトキシ ピリジン、4-メトキシピリジン、キノリン、イソキノ リン、ピリダジン、ピリミジン、ピラジン、シノリン、 フタラジン、キナゾリン、キノクサリン、アシリジン等 が挙げられる。

【0010】これらのうち触媒活性の面から、三級芳香族アミン化合物(イミンを除く)が好ましく用いられ、より好ましくはN、Nージメチルアニリン、ジフェニルメチルアミン及びトリフェニルアミンが用いられる。また、上記(c)三級芳香族アミン化合物(イミンを除く)及び/または窒素含有複素環式化合物(以下、

(c)成分と称する。)はそれぞれ単独で使用し得るの みならず、二種以上を混合して用いることも可能であ る。

【0011】また、co(c) 成分の使用量は、204 錯体1 モルに対して $0.01 \sim 10000$ 当量であり、好ましくは $0.05 \sim 3000$ 当量、より好ましくば $0.1 \sim 1000$ 当量である。(c) 成分の使用量が2000 は一日の日本のは一日の日本の場合は十分な活性が得られず、逆に10000 当量を越える場合は触媒活性が増加せず経済的でない。

【0012】本発明においては、エチレンの三量化触媒を構成する一成分として、(a)中性の多座配位子が配位したクロム錯体が用いられる。中性の多座配位子が配位したクロム錯体は、下記一般式(1)

 $ACrB_n$ (1)

(式中、Aは中性の多座配位子である。nは1~3の整数であり、Bは水素原子、炭素数1~10のアルキル基、炭素数1~10のカルボキシレート基、炭素数1~10のジケトナート基、ハロゲン原子、アミド基、イミド基、アルコキシド基、チオアルコキシド基、カルボニル配位子、アレーン配位子、アルケン配位子、アルキン配位子、イソニトリル配位子、イミン配位子、ニトリル配位子、イソニトリル配位子、ホスフィン配位子、ホスフィン配位子、ホスフィン配位子、ホスフィン配位子、ホスフィン配位子、ホスフィン配位子、ホスフィン配位子、エーテル配位子、スルホン配位子、スルホキシド配位子及びスルフィド配位子からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される錯体が好適なものとして挙げられる。

【0013】ここで、クロム錯体に配位させる中性の多 座配位子として用いられるものは特に限定されるもので はないが、例えば、下記一般式(3)

[0014]

【化1】

【0015】(式中、j, k, mはそれぞれ独立して0~6の整数である。 D^1 はそれぞれ独立して、置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、 L^1 はそれぞれ独立して、周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。また、 G^1 は炭素またはケイ素、 R^1 は水素基、炭素数1~10のアリール基を表す。)または下記一般式(4)

[0016]

【化2】

$$\left(\begin{array}{c} 2 \\ R \neq 0 \end{array}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ D = 0 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ C \end{bmatrix}$$

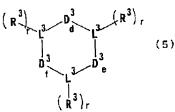
$$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ C \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ C \end{bmatrix}$$

【0017】(式中、a, b, cはそれぞれ独立して0 ~ 6 の整数であり、uは0または1の整数である。 D^2 はそれぞれ独立して、置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、 L^2 はそれぞれ独立して、周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。また、 G^2 は窒素またはリン、 R^2 は酸素またはイオウを表す。)で示される三脚型構造を有する9座配位子、下記一般式(5)

[0018]

【化3】



【0019】(式中、d, e, f はそれぞれ独立して1 \sim 6の整数であり、rは0または1の整数である。 D^8 はそれぞれ独立して、置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、 L^8 はそれぞれ独立して、周期表14族、15族、16族または17族元素、 R^8 は炭素数 $1\sim$ 10のアルキル基または炭素数 $1\sim$ 10のアリール基を表す。)で示される環状型構造を有する多座配位子及び下記一般式(6)

[0020]

【化4】



【0021】(式中、g、hはそれぞれ独立して0~6の整数である。D⁴はそれぞれ独立して、置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、L⁴及びL⁵はそれぞれ独立して、周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。)で示されるブリッジ型構造を有する多座配位子等が挙げられる。

【0022】上記一般式(3)、(4)、(5)及び(6)において、D¹、D²、D²及びD⁴としては特に限定されるものではないが、例えば、アルキレン基、シクロアルキレン基、フェニレン基、トリレン基、キシリレン基等が挙げられる。また、その置換基としては、例えば、メチル基、エチル基等のアルキル基類、メトキシ基、エトキシ基等のアルコキシ基類等が挙げられる。【0023】一般式(3)、(4)及び(6)におい

て、L1、L2及びL4で示される周期表14族、15 族、16族または17族元素を含有する置換基としては 特に限定されるものではないが、例えば、メトキシ基、 エトキシ基、プロボキシ基、ブトキシ基等のアルコキシ 基類、フェノキシ基、2、6-ジメチルフェノキシ基等 のアリールオキシ基類、メチルチオ基、エチルチオ基、 プロピルチオ基、ブチルチオ基等のアルキルチオ基類、 フェニルチオ基、トリルチオ基等のアリールチオ基類、 ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ビス (トリメチ ルシリル)アミノ基等のジアルキルアミノ基類、ジフェ ニルアミノ基等のジアリールアミノ基類、メチルフェニ ル基等のアルキルアリールアミノ基類、ジメチルホスフ ィノ基、ジエチルホスフィノ基等のジアルキルホスフィ ノ基、ジフェニルホスフィノ基、ジトリルホスフィノ基 等のジアリールホスフィノ基、メチルフェニルホスフィ ノ基等のアルキルアリールホスフィノ基類が挙げられ る。

【0024】また、フリル基、ベンゾフリル基、チエニル基、ベンゾチエニル基、ピラゾリル基、トリアゾリル基、ベンゾイミダゾリル基、ピリジル基、イミダゾリル基、ベンゾイミダゾリル基、インダゾリル基、キノリル基、イソキノリル基、オキサゾリル基、チアゾール基等の複素環基類が挙げられる。これらの複素環基の環上の置換基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、オクチル基、フェニル基等が挙げられる。【0025】一般式(3)におけるR1は特に限定されるものではないが、例えば、水素基類、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ベンジル基、ヒドロキシメチル基、シアノエチル基、アリル基、トリフルオロプロピル基等の炭素数1~10のアルキル基類またはフェニル基、pーメチルフェニル基、pークロロフェニル基等の炭素数1~10のアリール基類が挙げられる。

【0026】一般式(5)において、L³としては特に限定されるものではないが、例えば、リン原子、酸素原子またはイオウ原子等が挙げられる。また、R³としては特に限定されるものではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等の炭素数1~10のアルキル基類、またフェニル基、p-メチルフェニル基等の炭素数1~10のアリール基類が挙げられる。

【0027】一般式(6)において、L⁵で示される周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基としては特に限定されるものではないが、例えば、下記一般式(7)

[0028]

【化5】

$$\begin{pmatrix} \chi \\ R^4 \end{pmatrix}_t$$
 (7)

【0029】(式中、tは0または1の整数である。Yはリン原子、酸素原子またはイオウ原子、 R^4 は炭素数

 $1\sim10$ のアルキル基または炭素数 $1\sim10$ のアリール基を表す。)または下記一般式(8)

[0030]

【化6】

【0031】(式中、Zは酸素原子、イオウ原子、もしくは水素基、アルキル基またはアリール基を有するリン原子を表す。)で示されるものが挙げられる。

【0032】ここで、R4としては特に限定されるものではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等の炭素数1~10のアルキル基類、またはフェニル基、p-メチルフェニル基等の炭素数1~10のアリール基類が挙げられる。また、一般式(8)のアルキル基としては特に限定されるものではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等、アリール基としては、フェニル基、p-メチルフェニル基等が挙げられる。

【0033】上記一般式(3)または(4)で示される 三脚型構造を有する多座配位子として通常用いられるも のは特に限定されるものではないが、例えば、トリス (メトキシメチル) メタン、1,1,1-トリス(メト キシメチル)エタン、1、1、1-トリス(メトキシメ チル)プロパン、1,1,1-トリス(メトキシメチ ル)ブタン、1,1,1-トリス(エトキシメチル)エ タン、1,1,1-トリス(プロポキシメチル)エタ ン、1, 1, 1-トリス (ブトキシメチル) エタン、 1, 1, 1-トリス (フェノキシメチル) エタン、トリ フリルメタン、トリス (5-メチル-2-フリル) メタ ン、トリス(5-エチルー2-フリル) メタン、トリス (5ープチルー2ーフリル)メタン、1,1,1ートリ フリルエタン、トリフリルアミン、トリフリルホスフィ ン、トリフリルホスフィンオキシド等の含酸素多座配位 子類、1,1,1-トリス (メチルチオメチル) エタ ン、1,1,1-トリス(ブチルチオメチル)エタン、 1, 1, 1-トリス(フェニルチオメチル)エタン、ト リス (チエニル)メタン等の含イオウ多座配位子類、 1, 1, 1-トリス(ジメチルアミノメチル)エタン、 1, 1, 1-トリス(ジフェニルアミノメチル)エタ ン、トリス(ピラゾリル)メタン、トリス(3,5ージ メチルー1ーピラゾリル)メタン、トリス(3,5ージ イソプロピルー1ーピラゾリル)メタン、1,1,1-トリス(3,5-ジメチルー1ーピラゾリル)エタン、 1、1、1ートリス(3、5ージメチルー1ーピラゾリ ル)プロパン、1、1、1-トリス(3、5-ジメチル -1-ピラゾリル) ブタン、トリス(2-ピリジル) メ タン、トリス(6-メチルー2-ピリジル)メタン、ト リス(2-ピリジル)アミン、トリス(2-ピリジル) ホスフィン、トリス (2ーピリジル) ホスフィンオキシ ド、トリス(2-ピリジル)ヒドロキシメタン、トリス

(1-イミダゾリル)メタン等の含窒素多座配位子類、 1,1,1-トリス(ジフェニルホスフィノメチル)エ タン、1,1,1ートリス (ジメチルホスフィノメチ ル) エタン、1、1、1-トリス (ジエチルホスフィノ メチル)エタン等の含リン多座配位子類が挙げられる。 【0034】また、一般式(5)で示される環状型構造 を有する多座配位子としては特に限定されるものではな いが、例えば、1,3,5-トリメチル-1,3,5-トリアザシクロヘキサン、1、3、5-トリエチルー 1,3,5-トリアザシクロヘキサン、1,3,5-ト リーiープロピルー1,3,5-トリアザシクロヘキサ ン、1、3、5ートリーセーブチルー1、3、5ートリ アザシクロヘキサン、1,3,5-トリーnーブチルー 1,3,5-トリアザシクロヘキサン、1,3,5-ト リシクロヘキシルー1、3、5-トリアザシクロヘキサ ン、1, 3, 5ートリベンジル-1, 3, 5ートリアザ シクロヘキサン、1,3,5-トリフェニルー1,3, 5-トリアザシクロヘキサン、2,4,6-トリメチル -1, 3, 5-トリアザシクロヘキサン、1, 4, 7-トリアザシクロノナン、1,4,7-トリメチルー1, 4,7-トリアザシクロノナン、1,4,7-トリエチ ルー1、4、7ートリアザシクロノナン、1、4、7ー トリーiープロピルー1,4,7-トリアザシクロノナ ン、1,4,7-トリーtーブチル-1,4,7-トリ アザシクロノナン、1,4,7-トリシクロヘキシルー 1,4,7-トリアザシクロノナン、1,4,7-トリ フェニルー1,4.7ートリアザシクロノナン等の含窒 素多座配位子類、1,3,5-トリチアシクロヘキサ ン、1, 4, 7 – トリチアシクロノナン、1, 4, 7, 10ーテトラチアシクロドデカン、1,5,9,13-テトラチアヘキサデカン等の含イオウ多座配位子類、 1,3,5-トリオキサシクロヘキサン、1,4,7-トリオキサシクロノナン、12-クラウン-4、15-クラウンー5、18ークラウンー6等の含酸素多座配位 子類が挙げられる。

【0035】一般式(6)で示されるブリッジ型構造を 有する多座配位子としては特に限定されるものではない が、例えば、ビス (ジメチルホスフィノエチル) メチル ホスフィン、ビス(ジフェニルホスフィノエチル)フェ ニルホスフィン等の含リン多座配位子類、ジエチレント リアミン、ビス (ジメチルアミノエチル) メチルアミ ン、ビス(ジエチルアミノエチル) エチルアミン、ビス $(7x=\mu r \leq 1x \leq \mu r) r \leq \nu, \alpha, \alpha', \alpha'' = 1$ リピリジン、2.6-ビス(2-フェニルー2-アザエ テニル)ピリジン、ビス[3-(2-ピリジルエチルイ ミノ) -2-ブタノンオキシム] 等の含窒素多座配位子 類、ジエチレングリコールメチルエーテル、ビス(メト キシエチル) エーテル、ビス (エトキシエチル) エーテ ル、ビス(ブトキシエチル) エーテル、(セーブトキシ エチル) (メトキシエチル) エーテル等の含酸素多座配 位子類が挙げられる。

【0036】また、上記一般式(1)のBにおいて、炭 素数1~10の炭化水素基としては特に限定されるもの ではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロビル 基、ブチル基、シクロヘキシル基、ベンジル基またはフ ェニル基等が挙げられる。炭素数1~10のカルボキシ レート基としては特に限定されるものではないが、例え ば、アセテート基、ナフテネート基または2-エチルへ キサノエート基等が挙げられる。炭素数1~10のジケ トナート基としては特に限定されるものではないが、例 えば、アセチルアセトナート基等が挙げられる。ハロゲ ン原子としては特に限定されるものではないが、例え ば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子 等が挙げられる。アミド基としては特に限定されるもの ではないが、例えば、ジメチルアミド基、ジエチルアミ ド基、ジイソプロピルアミド基、ジオクチルアミド基、 ジデシルアミド基、ジドデシルアミド基、ビス(トリメ チルシリル)アミド基、ジフェニルアミド基、N-メチ ルアニリドまたはアニリド基等が挙げられる。イミド基 としては特に限定されるものではないが、例えば、ベン ゾフェノンイミド等が挙げられる。アルコキシド基とし ては特に限定されるものではないが、例えば、メトキシ ド基、エトキシド基、プロポキシド基、ブトキシド基ま たはフェノキシド基等が挙げられる。チオアルコキシド 基としては特に限定されるものではないが、例えば、チ オメトキシド基、チオエトキシド基、チオプロポキシド 基、チオブトキシド基またはチオフェノキシド基等が挙 げられる。アレーン配位子としては特に限定されるもの ではないが、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン、 トリメチルベンゼン、ヘキサメチルベンゼンまたはナフ タレン等が挙げられる。アルケン配位子としては特に限 定されるものではないが、例えば、エチレン、プロピレ ン、ブテン、ヘキセンまたはデセン等が挙げられる。ア ルキン配位子としては特に限定されるものではないが、 例えば、アセチレン、フェニルアセチレンまたはジフェ ニルアセチレン等が挙げられる。アミン配位子としては 特に限定されるものではないが、例えば、トリエチルア ミンまたはトリブチルアミン等が挙げられる。イミン配 位子としては特に限定されるものではないが、例えば、 ベンゾフェノンイミンまたはメチルエチルケトンイミン 等が挙げられる。ニトリル配位子としては特に限定され るものではないが、例えば、アセトニトリルまたはベン ゾニトリル等が挙げられる。イソニトリル配位子として は特に限定されるものではないが、例えば、セーブチル イソニトリルまたはフェニルイソニトリル等が挙げられ る。ホスフィン配位子としては特に限定されるものでは ないが、例えば、トリフェニルホスフィン、トリトリル ホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィンまたはトリ ブチルホスフィン等が挙げられる。ホスフィンオキシド 配位子としては特に限定されるものではないが、例え

【0037】上記一駅式・1)で示される中性の多座配 位子が配位した?ロニ語はお具体的な例としては特に限 定されるものではついん。 例えば、トリス (メトキシメ チル)メタンクロムトリクロライド(III)、1、 1,1-トリス (くトキシ メチル) エタンクロムトリカ ルボニル(0)、1、1、1-トリス(メトキシメチ ル) エタンクロムトリクロライド(III)、1,1, 1ートリス (メトキン (チル) エタンートリス (ジイソ プロビルアミド) クロム (III)、1、1、1ートリ ス (メトキシメチル・エクンートリス (ジメチルアミ ド) クロム (1 1 1) 、1、1、1 - トリス (メトキシ メチル) エタンートリス ビス(トリメチルシリル)ア ミド] クロム (111)、1、1、1-トリス (メトキ シメチル)エタンクロムトリエトキシド(III)、 1,1,1ートリス(メトキシメチル)エタンクロムト リチオブトキシド(111)、1,1,1-トリス(エ トキシメチル)エマンクロムトリクロライド(II I)、1,1,1-トリス(ブトキシメチル)エタンク ロムトリクロライド(111)、1,1,1-トリス (フェノキシメチル) エタンクロムトリクロライド(I II)、トリフリルメクンクロストリカルボニル。 (0)、トリス(5 メチル 2 フリル)メタンクロ ムトリカルボニル (0)、トリス (5-ブチルー2-フ リル)メタンクロムトリカルボニル(0)、トリフリル アミンクロムトリカルボニル(0)、トリフリルホスフ ィンクロムトリカルボニル(0)、トリフリルホスフィ ンオキシドクロムトリカルボニル(0)、1,1,1-トリス (メチルチオメチル) エタンクロムトリカルボニ ル(0)、トリス(チエニル)メタンクロムトリカルボ ニル(0)、1、1、1-トリス(ジメチルアミノメチ ル) エタンクロムトリカルボニル(0)、トリス(ピラ **ゾリル)メタンクロムトリカルボニル(0)、トリス** (3,5-ジメチルー1-ヒラゾリル)メタンクロムト リカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチルー1-

ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、 トリス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル)メタンー トリス(ジエチルアミド)クロム(III)、トリス (3,5ージメチルー1ーピラゾリル) メタンートリス **(ジイソプロピルアミド)クロム(III)、トリス** (3,5-ジメチルー1-ピラゾリル)メタンートリス [ビス(トリメチルシリル)アミド]クロム(II I)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メ **タンートリス (ベンゾフェノンイミド) クロム (II** I)、トリス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル)メ タンクロムトリエトキシド(III)、トリス(3,5 ージメチルー1ーピラゾリル)メタンクロムトリチオブ トキシド(III)、トリス(3,5-ジメチルー1-ピラゾリル)メタンートルエンクロム(0)、トリス (3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンクロム (エチレン) ジカルボニル(0)、トリス(3.5~ジ メチルー1-ピラゾリル) メタンクロム (フェニルアセ チレン)ジカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチ ルー1ーピラゾリル)メタンクロム(ジメチルアニリ ン)ジカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチルー 1-ピラゾリル) メタンクロム (ベンゾフェノンイミ ン)ジカルボニル(0)、トリス(3,5ージメチルー 1-ピラゾリル)メタンクロム(アセトニトリル)ジカ ルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラ ゾリル)メタンクロム(tーブチルイソニトリル)ジカ ルボニル(0)、トリス(3,5ージメチルー1ーピラ ゾリル) メタンクロム (トリブチルホスフィン) ジカル ボニル(0)、トリス(3,5ージメチルー1ーピラゾ リル)メタンクロム(トリブチルホスフィンオキシド) ジカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチルー1ー ピラゾリル)メタンクロム(トリフェニルホスファイ ト)ジカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチルー 1-ピラゾリル)メタンクロム(テトラヒドロフラン) ジカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチルー1-ピラゾリル) メタンクロム (ジメチルスルホン) ジカル ボニル(0)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾ リル)メタンクロム(ジメチルスルホキシド)ジカルボ ニル(0)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリ ル)メタンクロム(ジブチルスルフィド)ジカルボニル (0)、トリス(3,5ージイソプロピルー1ーピラゾ リル)メタンクロムトリカルボニル(0)、1,1,1 ートリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)エタン クロムトリカルボニル(0)、1,1,1-トリス (3,5-ジメチルー1-ピラゾリル)プロパンクロム トリカルボニル(0)、1,1,1-トリス(3,5-ジメチルー1ーピラゾリル)ブタンクロムトリカルボニ ル(0)、トリス(2-ピリジル)メタンクロムトリカ ルボニル(0)、トリス(6-メチル-2-ピリジル) メタンクロムトリカルボニル(0)、トリス(2-ピリ ジル) アミンクロムトリカルボニル(0)、トリス(2)

ーピリジル)ホスフィンクロムトリカルボニル(0)、 トリス (2ーピリジル) ホスフィンオキシドクロムトリ カルボニル(0)、トリス(1-イミダゾリル)メタン クロムトリカルボニル(0)、1,1,1ートリス(ジ フェニルホスフィノメチル) エタンクロムトリカルボニ ル(0)、1、1、1-トリス(ジフェニルホスフィノ メチル) エタンクロムトリクロライド(III)、1, 1、1-トリス(ジメチルホスフィノメチル)エタンク ロムトリカルボニル(0)、1,1,1-トリス(ジエ チルホスフィノメチル) エタンクロムトリカルボニル (0)、1,1,1-トリス(ジエチルホスフィノメチ ル) エタンクロムトリクロライド(III)、1, 1, **1-トリス (ジエチルホスフィノメチル) エタンートリ** ス(ジイソプロピルアミド)クロム(III)等の三脚 型構造を有する多座配位子が配位したクロム錯体が挙げ られる。

【0038】また、1,3,5-トリエチルー1、3, 5-トリアザシクロヘキサンクロムトリカルボニル (0)、1,3,5-トリーiープロピルー1,3,5 ートリアザシクロヘキサンクロムトリカルボニル (0), 1, 3, 5-hy-i-ypuuh-1, 3, 5 ートリアザシクロヘキサンクロムトリクロライド(II I)、1,3,5-トリーi-プロピルー1,3,5-トリアザシクロヘキサンクロムジクロライド(II)、 ジクロロフェニルクロム-1,3,5-トリメチルー 1,3,5-トリアザシクロヘキサンクロム(II I)、ジクロロフェニルクロム-1,3,5-トリーi ープロピルー1,3,5ートリアザシクロヘキサンクロ ム(III)、1、3、5ートリーセーブチルー1、 3, 5-トリアザシクロヘキサンクロムトリカルボニル (0)、1,3,5-トリーtーブチルー1,3,5-トリアザシクロヘキサンクロムトリクロライド(II I)、1,3,5-トリーセーブチルー1,3,5-ト リアザシクロヘキサンートリス (ジイソプロピルアミ ド) クロム (I I I) 、1, 3, 5-トリシクロヘキシ ルー1,3,5-トリアザシクロヘキサンクロムトリカ ルボニル(0)、2,4,6-トリメチル-1,3,5 ートリアザシクロヘキサンクロムトリカルボニル (0)、1,4,7-トリメチル-1,4,7-トリア ザシクロノナンクロムトリクロライド(I I I)、1, 4,7-トリーセーブチルー1,4,7-トリアザシク ロノナンクロムトリカルボニル(0)、1,3,5ート リチアシクロヘキサンクロムトリカルボニル(0)、 1,4,7-トリチアシクロノナンクロムトリカルボニ ル(0)、1、3、5-トリオキサシクロヘキサンクロ ムトリカルボニル(0)、1,4,7-トリオキサシク ロノナンクロムトリカルボニル(0)等の環状型構造を 有する多座配位子が配位したクロム錯体が挙げられる。 【0039】さらに、ビス(ジメチルホスフィノエチ ル)メチルホスフィンクロムトリクロライド(11

1)、ビス(ジフェニルホスフィノエチル)フェニルホスフィンクロムトリカルボニル(0)、ビス(ジフェニルホスフィンクロムトリクロライド(111)、ジエチレントリアミンクロムトリクロライド(111)、ジエチレントリアミンクロムトリクロライド(111)、 α 、 α 、 α " -トリピリジンクロムトリクロライド(111)、2 、6 - ビス(2 - 2

【0040】これらのうち1-ヘキセン選択性や触媒活 性の面から、一般式(1)の中性の多座配位子としては 三脚型構造を有する多座配位子が好ましく用いられる。 また、Bとしてはカルボニル配位子、炭素数1~10の 炭化水素基、ハロゲン原子、アミド基、アルコキシド基 及びチオアルコキシド基が好ましく用いられる。より好 ましくは三脚型構造を有する多座配位子が配位したクロ ムのカルボニル錯体、三脚型構造を有する多座配位子が 配位したクロムのハロゲン錯体及び三脚型構造を有する 多座配位子が配位したクロムのアミド錯体が用いられ る。さらに好ましくは、トリス(3,5ージメチルー1 ーピラゾリル)メタンクロムトリカルボニル(0)、ト リス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル)メタンクロ ムトリクロライド(III)、トリス(3,5-ジメチ ルー1-ピラゾリル)メタンートリス(ジイソプロピル アミド) クロム(III)、1,1,1ートリス(メト キシメチル)エタンクロムトリカルボニル(0)等が用 いられる。

【0041】本発明において、上記の中性の多座配位子 が配位したクロム錯体の合成法は特に限定されるもので はないが、例えば、中性の多座配位子とクロム化合物と から公知の錯体形成法 [例えば、J. Amer. Che m. Soc., 92, 5118 (1970) 及びAng ew. Chem. Int. Ed. Engl., 33, 1 877(1994) 等] により容易に合成することがで きる。この場合、使用できるクロム化合物としては特に 限定されるものではないが、例えば、クロムヘキサカル ボニル(0)、ペンタカルボニル(トリフェニルホスフ ィン) クロム(0)、テトラカルボニルビス(エチレ ン) クロム(0)、トリカルボニル(ベンゼン) クロム (0)、トリカルボニル(トルエン)クロム(0)、ト リカルボニル (トリメチルベンゼン) クロム (0)、ト リカルボニル(ヘキサメチルベンゼン)クロム(0)、 トリカルボニル (ナフタレン) クロム(0)、トリカル ボニル(シクロヘプタトリエン)クロム(0)、トリカ

ルボニルトリス (アセトニトリル) クロム (0)、トリ カルボニルトリス (トリフェニルホスファイト) クロム (0)、(エチレン)ジカルボニル(トリメチルベンゼ ン)クロム(0)、シクロヘキシルイソニトリルジカル ボニル (トリメチルベンゼン) クロム(0)、トリブチ ルホスフィンジカルボニル (トリメチルベンゼン)クロ ム(0)、トリカルボニル(シクロペンタジエニル)ク ロム(I)ダイマー、ヒドリドトリカルボニル(シクロ ベンタジエニル)クロム(II)等のクロムカルボニル 化合物類、塩化クロム(III)、塩化クロム(I I)、臭化クロム(III)、臭化クロム(II)、ヨ ウ化クロム(III)、ヨウ化クロム(II)、フッ化 クロム(III)、フッ化クロム(II)、トリス(テ トラヒドロフラン) クロムクロライド(III)、トリ ス(1,4-ジオキサン)クロムクロライド(II I)、トリス(ジエチルエーテル)クロムクロライド (111)、トリス(ピリジン)クロムクロライド(1 II)、トリス(アセトニトリル)クロムクロライド (ІІІ) 等のクロムハロゲン化物類、トリス (テトラ ヒドロフラン)クロムトリス(ジイソプロピルアミド) (ІІІ)、トリス(テトラヒドロフラン)クロムトリ ス(ジエチルアミド)(III)等のクロムアミド類、 クロム(IV) tープトキシド等のクロムアルコキシド 類、クロム(III)アセチルアセトナート等のクロム ジケトナート類、クロム(III)2-エチルヘキサノ エート、クロム(III)アセテート、クロム(II I) ナフテネート等のクロムカルボン酸塩類が挙げられ

【0042】中性の多座配位子とクロム化合物を反応させ、クロム錯体を形成させる際のクロム金属の濃度は特に制限されない。また、ここで用いられる溶媒としては特に限定されるものではないが、有機溶媒が好ましく用いられる。例えば、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン、シクロヘキサン、デカリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キシレン、クメン、トリメチルベンゼン等の芳香族炭化水素類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル類、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素類が挙げられる。また、上記溶媒はそれぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

【0043】また、錯体形成反応の温度は、-80℃から使用する反応溶媒の沸点までの任意の温度で行われ、好ましくは20~200℃である。反応溶媒の沸点以上の温度で錯形成反応を行う場合には、加圧下で行うこともできる。反応時間は特に制限されず、通常1分~48時間、好ましくは5分~24時間である。なお、反応時のすべての操作は、空気と水分を避けて行なうことが望ましい。また、原料及び溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0044】中性の多座配位子が配位したクロム錯体は、通常固体として沈殿するので、ろ別により反応溶媒から分離できる。さらに、必要に応じて、上記溶媒を用いて洗浄を行い、次いで乾燥してエチレンの三量化触媒の構成成分の一つであるクロム錯体が合成される。なお、沈殿しない場合は、溶媒留去、貧溶媒の添加あるいは冷却処理等により沈殿させることができる。

【0045】本発明においては、中性の多座配位子が配位したクロム錯体のうち、その多座配位子がfacialに配位したクロム錯体を用いることが好ましい。多座配位子がfacialに配位したクロム錯体を用いることにより、ポリエチレンの副生が抑えられる等の効果が認められる。ここで、多座配位子がfacialに配位した錯体とは、多座配位子により3つの配位座が占有された6配位八面体型錯体の異性体の一つである[化学選書 有機金属化学-基礎と応用-、143頁(裳華房)]。即ち、多座配位子により3つの配位座が占有された6配位八面体型錯体において、多座配位子が、3つの配位座が互いにシス位になるような配置で配位していることを意味する。

【0046】本発明において使用される(b)アルキル 金属化合物は特に限定されるものではないが、例えば、 下記一般式(2)

 $R_{o}MX_{\sigma}$ (2)

(式中、pは0<p≤3であり、qは0≤q<3であって、しかもp+qは1~3である。Mはリチウム、マグネシウム、亜鉛、ボロンまたはアルミニウムを表し、Rは炭素数1~10のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表し、Xは水素原子、アルコキシド基、アリール基及びハロゲン原子からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される化合物が好適なものとして挙げられる。

【0047】上記一般式(2)において、炭素数1~1 0のアルキル基としては特に限定されるものではない が、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル 基、シクロヘキシル基またはオクチル基等が挙げられ る。アルコキシド基としては特に限定されるものではな いが、例えば、メトキシド基、エトキシド基、ブトキシ ド基またはフェノキシド基等が挙げられる。アリール基 としては特に限定されるものではないが、例えば、フェ ニル基等が挙げられる。ハロゲン原子としては特に限定 されるものではないが、例えば、フッ素、塩素、臭素ま たはヨウ素が挙げられる。

【0048】なお、上記一般式(2)において、MがA 1で、pとqがそれぞれ1.5のとき、 $A1R_{1.5}X_{1.5}$ となる。このような化合物は、理論的には存在しないが、通常、慣用的に $A1_2R_3X_3$ のセスキ体として表現されており、これらの化合物も本発明に含まれる。

【0049】上記一般式(2)で示されるアルキル金属 化合物としては、例えば、メチルリチウム、エチルリチ ウム、プロビルリナウム、ローブチルリチウム、S=ブ チルリチウン・ナー・チルリチウム、ジエチルマグネシ ウム、エチル・チルマグイジウム、エチルクロロマグネ シウム、エキリコロモコケネシウム、ジメチル亜鉛、ジ エチル亜痛 シュトル亜痛、トリメチルボラン、トリエ チルホッショーロマ ヤルアルミニウム、トリエチルアル ミニウム・トリイソフチルアルミニウム、トリーローへ キシルフルミニウム。トリーローオクチルアルミニウ ム、トリングロー、ペンルアルミニウム、ジメチルエチル アルミニウム シェチルアルミニウムヒドリド、ジイソ ブチルアルミニウムヒドリド、ジエチルアルミニウムエ トキシド、シェ・ルアルミニウムフェノキシド、ジシク ロヘキシルフ・ニルプルミニウム、エチルアルミニウム エトキングロリー しェチルアルミニウムクロリド、ジ エチルアルミニウムプロニド、ジイソブチルアルミニウ ムクロリド、シングロイ、キンルアルミニウムクロリド、 メチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウ ムセスキクロリト フォルアルミニウムセスキクロリ ド、エチルアルミニウムジクロリド、イソブチルアルミ 二ウムジクロリレスが全げられる

【0050】これられ、け、八手の容易さ及び活性の面から、アルキルマルミニウム化合物が好ましく用いられ、さらに好ましくはトリエチルマルミニウムまたはトリイソブチルアルミニウムが用いられる。これらのアルキル金属化合物は単独で使用し得るのみならず、三種以上を混合して用いることも可能である。

【0051】アルキル室国化合物の使用量は、クロム錯体1モルに対してロ、1~10000当量であり、好ましくは3~3000当量、より好ましくは5~2000当量である。

【0052】本充明の(a)中性の多座配位子が配位したクロム錯体(以下、(a)成分と称す。)、(b)アルキル金属化合物(以下、(b)成分と称す。)及び(c)三級芳香族でミン化合物(イミンを除く)及び/または窒素含有複素環式化合物((c)成分)からなるエチレンの三量化腫媒は、前記の(a)成分、(b)成分及び(c)成分を原料に、落媒中で接触させることにより調製できる。接触方法は特に制限されない。

【0053】この触線を調製する際のクロム錯体の濃度は特に制限されないが、通常、溶媒11あたり0.00 1マイクロモル~100ミリモル、好ましくは0.01 マイクロモル~10ミリモルの濃度で使用される。これより小さい触媒濃度では十分な活性が得られず、逆にこれより大きい触媒濃度では触媒活性が増加せず経済的でない。また、ここで用いられる溶媒としては、例えば、ブタン、ペンタン、ヘキサン、オクタン、イソオクタン、ノナン、デカン、シクロペンタン、シクロペナウン、メチルシクロヘキサン、シクロオクタン、デカリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、クメン、トリメチルベンゼ ン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン等の芳香族炭化水素類及び塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン等の塩素化炭化水素類が挙げられる。また反応生成物、即ち、1ーヘキセンを溶媒として用いることもできる。これらの溶媒はそれぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。ここで、エチレンの三量化反応時のクロム錯体濃度をコントロールする目的で、必要に応じて濃縮や希釈しても差し支えない。

【0054】また、前記の(a)成分、(b)成分及び、(c)成分を接触させる際の温度は-100~250 ℃、好ましくは0~200℃である。接触時間は特に制限されず、1分~24時間、好ましくは2分~12時間である。なお、接触時のすべての操作は、空気と水分を避けて行なうことが望ましい。また、原料及び溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0055】本発明のエチレンの三量化反応は、前記の(a)成分、(b)成分及び(c)成分からなる触媒とエチレンを接触させることにより行うことができる。接触方法は特に制限されないが、例えば、三量化反応の原料であるエチレンの存在下に、(a)成分、(b)成分及び(c)成分を接触させて、接触と同時に三量化反応を開始する方法、または(a)成分、(b)成分及び(c)成分を前もって接触させた後、エチレンと接触させて三量化反応を行う方法が採られる。

【0056】具体的には、前者の場合は、(1)(a)成分、(b)成分、(c)成分及びエチレンをそれぞれ同時に独立に反応系に導入する、(2)(b)成分を含む溶液に(a)成分、(c)成分及びエチレンを導入する、(3)(a)成分、(c)成分を含む溶液に(b)成分及びエチレンを導入する、(4)(b)成分及び(c)成分を含む溶液に(a)成分及びエチレンを導入する、(5)(a)成分を含む溶液に(b)成分、

(c)成分及びエチレンを導入する、という方法により 触媒を調製することができる。また、後者の場合は、

(1)(a)成分及び(c)成分を含む溶液に(b)成分を導入する、(2)(b)成分及び(c)成分を含む溶液に(a)成分を導入する、(3)(b)成分を含む溶液に(a)成分及び(c)成分を導入する、(4)(a)成分を含む溶液に(c)成分と(b)成分を導入

(a) 成分を含む浴欲に(c) 成分と(b) 成分を導入する、という方法により触媒を調製することができる。なお、これらの原料の混合順序は特に制限されない。

【0057】本発明においては、必要に応じて(a)成分、(b)成分及び(c)成分からなる触媒に光を照射し、エチレンの三量化反応を行ってもよい。光の照射により触媒活性が大幅に向上する等の効果が認められる。【0058】本発明において使用される光は特に限定されるものではないが、例えば、紫外光、可視光、赤外光が挙げられ、発光波長としては、1~2000nmの光

が好ましく、より好ましくは200~700 nmの光が

用いられる。また、光の照度は特に制限されない。

【0039】光の光源としては、太陽光または人工光源のいずれを用いても良いが、太陽光は照度が小さく、天候に影響され、夜間の使用ができないことから、人工光源が望ましい。人工光源としては特に限定されるものではないが、例えば、重水素ランプ、キセノンランプ、タングステンランプ、白熱電球、ハロゲンランプ、低圧水銀ランプ、ホローカソードランプ、金属蒸気放電管、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプ、タリウムランプ、水銀ータリウムランプ、水銀ー鉛ランプ、日型放電管、キセノン・水銀ランプ、高圧水銀ランプ、超高圧水銀ランプ、フラッシュランプ等が挙げられる。

【 O O o O 】光の照射時期は特に制限されるものではないが、前記の(a)成分、(b)成分及び(c)成分からなる神媒に照射してもよいし、またエチレンの三量化反応系に直接照射してもよい。なお、光の照射時間は特に制限されない。

【ロロ61】木を明におけるエチレンの三量化反応の温度は、-100~250℃であるが、好ましくは0~200℃である。好ましくは0~200℃である。好ましては0℃を開気であれば特に制限されないが、絶対圧で0.01~300kg

で加てある。また、反応時間は温度や圧力に左右され、一概に決めることはできないが、5秒~6時間である。また、エチレンは、前記の圧力を保つように連続的に供給してもよいし、反応開始時に前記圧力で封入して反応させてもよい。原料ガスであるエチレンには、反応に不活性なカス。例えば窒素、アルゴン、ヘリウム等が含まれていても何ら差し支えない。なお、エチレンの三量化反応のすべての操作は、空気と水分を避けて行うことが望ましい。また、エチレンは十分に乾燥しておくことが好ましい。

【 0 0 6 2】木反応は、回分式、半回分式、連続式のいずれでも実施できる。エチレンの三量化反応終了後、反応液に、例えば、水、アルコール、水酸化ナトリウム水溶液等の失活剤を添加して反応を停止させることができる。失活した呪クロム触媒は、公知の脱灰処理方法、例えば、水またはアルカリ水溶液による抽出等で除去できる。生成した1 ヘキセンは、公知の抽出法や蒸留法により反応液より分離される。また、副生するボリエチレンは、反応液出口で公知の遠心分離法や1ーヘキセンの蒸留分離の際の残渣として分離除去することができる。

[0063]

【実施例】以下に、本発明を実施例を用いてさらに詳細 に説明するが、これらの実施例は本発明の概要を示すも ので、本発明はこれらの実施例に限定されるものではな い。

【 0 0 6 4 】 I R 測定: I R は、島津製作所製 赤外分 光光度計 (FT I R ~ 8 1 0 0) を用いて、ヌジョール 法で測定した。 【0065】ガスクロマトグラフィーによる分析: 反応 液中に含まれる炭素数4~8の生成物の定量は、GLサイエンス製 TC-1のカラムを装着した島津製作所製 ガスクロマトグラフ (GC-14A) を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度280℃、検出器温度280℃に設定し、内部標準としてn-ヘプタンを用いた。分析は、このガスクロマトグラフに反応液を1.0μ1注入した後、カラムの温度を40℃から250℃まで昇温することにより行った。

【0066】また、炭素数10以上の生成物は、上記ガスクロマトグラフとは別途用意したGLサイエンス製TC-1のカラムを装着した島津製作所製 ガスクロマトグラフ(GC-14A)を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度300℃、検出器温度300℃に設定し、内部標準としてnーヘプタンを用いた。分析は、このガスクロマトグラフに反応液を1.5μ1注入した後、カラムの温度を50℃から300℃まで昇温することにより行った。

【0067】気体中に含まれる生成物は、クロムパック製 A1₂O₃/KC1のカラムを装着した島津製作所製ガスクロマトグラフ(GC-9A)を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度200℃、検出器温度200℃及びカラム温度120℃に設定し、絶対検量線法を用いた。分析は、このガスクロマトグラフに回収した気体を0.2ml注入することにより行った。

【0068】参考例1

シュレンク管に、J. Amer. Chem. Soc., 92,5118 (1970) に記載の方法で合成した三脚型構造を有するトリス(3.5ージメチルー1ーピラゾリル)メタン 238mg、クロムへキサカルボニル176mg、メシチレン40ml及びトルエン10mlを加え、窒素雰囲気下で1時間撹拌しながら加熱還流した。析出した結晶をろ別し、トリス(3.5ージメチルー1ーピラゾリル)メタンクロムトリカルボニル(0)(以下、錯体Aと称する。)を得た。この錯体のIR分析を行った結果、CO吸収に基づく2本のピークが1896cm⁻¹と1759cm⁻¹に認められ、トリス(3.5ージメチルー1ーピラゾリル)メタンがクロムにfacialで配位していることを示した。

【0069】実施例1

内容積50m1のステンレス容器に、0.028mo1/10N,N-ジメチルアニリン/トルエン溶液<math>1.4m1及び乾燥したトルエン40m1を入れた(以下、溶液Bと称する。)。

【0070】温度計及び撹拌装置を備えた内容積150mlのガラス製耐圧反応容器に、参考例1で合成した錯体Aを1.7mg、0.24mol/1のトリイソブチルアルミニウム/シクロヘキサン溶液2.0mlと乾燥

したトルエン40mlを入れ、混合撹拌した。反応容器 を80℃に加熱し、撹拌速度を1400rpmに調整 後、反応容器にエチレンを導入して、反応容器内の絶対 圧力を5kg/cm²とした。ウシオ電気製 超高圧水 銀ランプ(500W)を用い、外部から光を5分間照射 した後、上記溶液Bをエチレンで圧入した。

【0071】以後、エチレンを前記圧力を維持するよう に導入し続け、80℃、5kg/cm2の反応条件を保 った状態で30分反応を行なった。30分後、反応容器 中に水を窒素で圧入することによって触媒を失活させて 反応を停止した。

【0072】反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧し た。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガス クロマトグラフィーにより分析した。また、反応液に含 まれる固体分をろ紙を用いてろ別し、これを風乾後、減 圧下で乾燥(1Torr,100℃)してその重量を測 定し、ポリマー重量とした。結果を表1に示す。

【0073】実施例2

0.028mo1/1のN, N-ジメチルアニリン/ト ルエン溶液0.29mlを用いたこと以外、実施例1と 同様にして反応を行なった。結果を表1に示す。

【0074】実施例3

0.028mo1/1のN, N-ジメチルアニリン/ト ルエン溶液2.9mlを用いたこと以外、実施例1と同 様にして反応を行なった。結果を表1に示す。

【0075】実施例4~6

N,N-ジメチルアニリンの代わりに、表1に示す三級 芳香族アミン化合物を用いたこと以外、実施例1と同様 にして反応を行なった。結果を表1に示す。

【0076】比較例1

N,N-ジメチルアニリンを用いなかったこと以外、実 施例1と同様にして反応を行なった。 結果を表2に示

【0077】比較例2

N、N-ジメチルアニリンの代わりに、三級脂肪族アミ ンであるN, Nージメチルオクタデシルアミン 12m gを用いたこと以外、実施例1と同様にして反応を行な った。結果を表2に示す。

【0078】比較例3

N、N-ジメチルアニリンの代わりに、二級アミンであ るジドデシルアミン14mgを用いたこと以外、実施例 1と同様にして反応を行なった。結果を表2に示す。

[0079]

【表1】

		実施例 1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6
89 kg							
Cr錯体		循体ム	錯体A	銀体人	猶体A	箱体A	錯体A
	umo;	4. 0	4. 0	4. 0	4. 0	4. 0	4.0
アルキル金属化合物		(-BusAl	i-BusA1	i BusA l	i-BusAl	i −Bu₃A l	i-BusAl
	umo i	480	480	480	480	480	480
三級芳香族アミン		PhNMez	PhNMe ₂	PhNMe ₂	PhN(Pr-nl2	Ph₂NMe	₽h₃N
	umol	40	8	80	40	40	40
溶媒		トルエン	トルエン	トルエン	トルエン	トルエン	トルエン
反応条件							
反应温度	tc	80	80	80	80	80	80
反応圧力	kg/cm ²	5	5	5	5	5	5
反应時間	2	30	30	3.0	30	30	30
結果							
触媒活性g-1-	N+t3/g-Cr·h	12600	8380	13000	11900	9050	15600
			ĺ			ļ	
液体	wt%	99. 9	>99. 9	99, 9	99. 7	>99.9	>99. 9
個体 (PE)	w t %	0. 1	trace	0. 1	0.3	trace	trace
液体中の	w t %			·	1		i
生成物分布	C4	1.2	1.6	1. 1	0, 9	1. 5	1.0
	Č6	97. 6	96. 5	96. 9	96. 6	96. 4	97.0
	CB	0. 2	0. 1	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2
	C10	0.6	1.3	1. 1	1. 2	1.1	1.1
	C12+	0.4	0. 5	0. 7	1.2	0.8	0.7
C 6純度	wt%	99. 1	99. 1	99. 1	99. 2	99. 2	99. 1

(注) Ph NMea: NN-y メチルテーリッ、 Ph N/Pr-na: : NN-t メ[n-プロピルアップロピルアップロッ)、 PhaNMe: メワルク アュニルヤミン、 PhaN: トリワュニルヤミン C6: ヘキセン、C8: オクテン、C10: デセン、C12: ドデセン以上の高級オレフィン PE: ポリエチレン、 C6銭度= (1 ーヘキセン/ヘキセン興性体)×100

【表2】

[0080]

	比較例1	比較例2	比較例3	
触媒				
C r 錯体	指体A	鋸体A	醤体ム	
l om u	4. 0	4. 0	4. 0	
アルキル金属化合物	i —BuaA l	i – Bu »A l	i –Bu ₃ A l	
μmo l	480	480	480	
三級芳香族アミン	_	C18H37NMe2	(C12H2sl2NH	
umo l	_	40	40	
熔媒	トルエン	トルエン	トルエン	
反応条件				
反応温度 *C	80	80	80	
反応圧力 kg/cm	_	5	5	
反応時間 分	30	30	30	
結果	. [
触媒活性g-1-Aft2//g-Cr·h	1 4870	5000	4330	
液体 wt%	>99. 9	99. 0	>99. 9	
個体(PE) wt%	trace	1.0	trace	
液体中の w t%				
生成物分布 С4	2. 4	1.9	2. 7	
Ç6	95.6	94. 4	95. 0	
C8	0. 2	0. 2	0. 2	
C10	1. 4	1.8	1. 3	
C12+	0. 4	1.7	0. 8	
C6網度 wt%	99. 1	99, 1	99. 1	

C4: プテン、C6: ヘキセン、C8: オクテン、C10: デセン、C12: ドデセン以上の高級オレフィン

PE: ポリエチレン、 C6純度= (1-ヘキセン/ヘキセン異性体)×100

[0081]

٦

【発明の効果】本発明によれば、(a)中性の多座配位子が配位したクロム錯体、(b)アルキル金属化合物及び(c)三級芳香族アミン化合物(イミンを除く)及び

/または窒素含有複素環式化合物の少なくとも3成分からなるエチレンの三量化触媒を用いるとエチレンから効率よく、かつ高選択的に1-ヘキセンを製造することができる。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4J028 AA01A AB00A AC42A BA01A

BA01B BB00A BB00B BB01A

BB01B BC01A BC01B BC05A

BC05B BC06A BC06B BC09A

BC09B BC13A BC13B BC15A

BC15B BC16A BC16B BC17A

BC17B BC19A BC19B BC24A

BC24B BC27A BC27B CB64A

CB64B CB64C CB65A CB65B

CB65C CB74A CB74B CB74C

CB75A CB75B CB75C CB77A

CB77B CB77C DB04A DB04B

DB05A DB05B DB05C EA01

EB02 EC01 FA02 FA06 FA07

FA10 GB01

4J100 AA02P CA01 DA02 FA08

FA09 JA00

THIS PAGE BLANK (USPTO)